



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ**

Номер регистрации (свидетельства):
2019630099

Дата регистрации: 22.05.2019

Номер и дата поступления заявки:
2019630081 30.04.2019

Дата публикации и номер бюллетеня:
22.05.2019 Бюл. № 6

Дата первого использования:
12.01.2019

Дата истечения срока действия
исключительного права: 12.01.2029

Автор(ы):

Дроздов Алексей Викторович (RU),

Дроботун Николай Борисович (RU),

Данилов Даниил Сергеевич (RU),

Жидик Юрий Сергеевич (RU)

Правообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники» (RU)

Название интегральной микросхемы с зарегистрированной топологией:
SPDT_G75

Реферат:

ИМС выполнена по технологии арсенид-галлиевых (GaAs) монолитно-интегральных схем и представляет собой функционально законченный узел переключателя сверхвысокочастотных (СВЧ) сигналов с общим входом и двумя коммутируемыми выходами. В качестве коммутирующих элементов использованы гетеро-структурные полевые транзисторы с длиной затвора 0,1 мкм. Особенностью данной ИМС является повышенная изоляция в отключенном состоянии и минимальные потери в открытом состоянии. Диапазон рабочих частот - 0-50 ГГц. Потери на проход - не более 2 дБ, возвратные потери по входу и выходу не менее -13 дБ, изоляция в выключенном состоянии - не менее 50 дБ. ИМС управляется логическими сигналами с уровнями 0 В и -5 В. Габаритные размеры кристалла до резки 1 X 0,7 мм.